

Микросхемы КР580ИК80А

Э Т И К Е Т К А



Полупроводниковая интегральная микросхема КР580ИК80А
— 8-разрядное параллельное центральное процессорное устройство.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

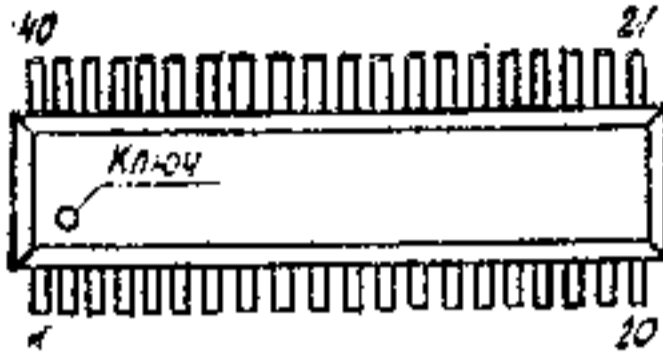


Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода
1	A10	21	HL DA
2	0V	22	F1
3	D4	23	REA DV
4	D5	24	WAIT
5	D6	25	A0
6	D7	26	A1
7	D3	27	A2
8	D2	28	Исс ₁
9	D ¹	29	A3
10	D ⁰	30	A4
11	Исс ₃	31	A5
12	RESET	32	A6
13	HOLD	33	A7
14	IND	34	A8
15	E2	35	A9
16	INTE	36	A15
17	DBIN	37	A12
18	\overline{WR}	38	A13
19	SYNC	39	A14
20	Исс ₂	40	A11

Основные электрические параметры при $T = 25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма		Примечание
	не менее	не более	
1. Выходное напряжение высокого уровня, В	3,7	—	1
2. Выходное напряжение низкого уровня, В	—	0,4	1
3. Ток потребления от источника питания 1, мА	—	50	2
4. Ток потребления от источника питания 2, мА	—	70	2
5. Ток потребления от источника питания 3, мА	—	1	2
6. Входной ток высокого уровня на управляющих входах, мкА	—1	1	3
7. Входной ток низкого уровня на управляющих входах, мкА	—1	1	3
8. Входной ток высокого уровня на фазных входах, мкА	—1	1	4
9. Выходной ток в состоянии „Выключено“, мкА	—10	10	5

- Примечания:**
1. При $I_{сс1} = 11,4 \text{ В}$, $I_{сс2} = 4,75 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 5,25 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 10 \text{ В}$, $I_{LF} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,5 \text{ мГц}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$.
 2. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{LF} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$.
 3. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$, $f_F = 2,0 \text{ мГц}$
 4. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$
 5. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $C_L = 100 \text{ пФ}$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Таблица 3

Наименование параметра, единица измерения	Норма			
	Предельно допустимый режим		Предельный режим	
	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение источника питания 1 на выводе 28, В	—	13,2	—	14
Напряжение источника питания 2 на выводе 20, В	—	5,25	—	5,5
Напряжение источника питания 3 на выводе 11, В	—5,25	—	—6	—

Напряжение высокого уровня импульсов фаз F1, F2 В	—	13	—	14
Напряжение низкого уровня импульсов фаз F1, F2 В	—0,3	—	—	—
Входное напряжение высокого уровня, В	—	5,25	—	6,0
Входное напряжение низкого уровня, В	—0,3	—	—	—
Напряжение высокого уровня, подаваемое на шины данных и адреса в режиме „HOLD“ и в период действия сигнала „RESET“, В	—	5,25	—	—
Напряжение низкого уровня, подаваемое на шины данных и адреса в режиме „HOLD“ и в период действия сигнала „RESET“, В	—0,3	—	—	—
Выходной ток высокого уровня, мА	—	0,1	—	0,1
Выходной ток низкого уровня, мА	—	1,8	—	2,0

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото —2,4980 г

Содержание цветных металлов.

Рамка выводная, плакированная алюминием

никеля—0,3 г

Сведения о приемке

Микросхема КР580ИК80А соответствует техническим условиям БКО.348.527 ТУ

Место для штампа ОТК

Указания по эксплуатации

Микросхемы должны применяться только в соответствии с их функциональным назначением в режимах и условиях, оговоренных техническими условиями.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. Пайку выводов проводить, применяя припой ПОС-61 и флюс ФКСп. При эксплуатации микросхем необходимо применять меры защиты их от воздействия статистического потенциала—30В. Категория микросхем—2, вид климатического исполнения УХЛ. (В—при условии защиты микросхем в составе аппаратуры тремя слоями лака УР-231 ТУ 6-10-863-84).

Замену микросхем при ремонте аппаратуры, установку и извлечение микросхем из контактных приспособлений необходимо производить при отсутствии напряжения на выводах микросхемы.

Рекомендуется одновременная подача и отключение всех питающих напряжений на микросхему.

Допускается неодновременная подача питающих напряжений с соблюдением последовательности включения источников питания: $Исс_3 = -5В$, $Исс_2 = 5В$, $Исс_1 = 12В$. Отключение производится в обратном порядке.